

# CURRICULUM VITAE

## Informations personnelles

Nom Rami Boumaraf  
Adresse ap. 155 B8 city 748 El-Alia Biskra  
Tel. +213 661 424865  
E-mail rami.boumaraf@univ-biskra.dz  
Né le 17 September 1985



## Éducation / Qualifications

2005 Baccalauréat, section science naturelle et de la vie  
2005-2008 Licence en Physique, option : Physique des Matériaux à l'université de Biskra.  
Mémoire : les jonctions PN et leurs caractéristiques réelles.  
2008-2010 Master en Physique, option : Physique des Matériaux à l'université de Biskra.  
Mémoire : Simulation d'un transistor bipolaire a hétérojonction (HBT Si/SiGe/Si).  
Major de promotion, moyen : 14.85.  
2011- 2015 Doctorat en Physique, option : Physique des Matériaux à l'université de Biskra. Thèse : Simulation de l'effet de la température et les défauts sur les caractéristiques électriques des diodes à base de GaAs.

## Emploi / Expérience professionnelle

2012- 2013 Université de Biskra, Biskra Algérie.  
Poste : aide-enseignant.  
2015-2016 Université de Biskra, Biskra Algérie.  
Poste : Maitre-Assistant A.  
2016-present Université de Biskra, Biskra Algérie.  
Poste : Maitre de conférences B.  
2015-present membre au Laboratoire de Matériaux Semiconducteurs et Métalliques  
« LMSM » Biskra.  
2018-present Responsable de spécialité « physique » au département des science de la matière, Faculté des sciences exactes et sciences de la nature et de la vie, université de Biskra.

## Production scientifique / Activités

Boumaraf, R., Sengouga, N., et al., "Deep traps and temperature effects on the capacitance of p-type Si-doped GaAs Schottky diodes on (211) and (311) oriented GaAs

- substrates”. Superlattices and Microstructures, 2014. 65(0): p. 319-331.
- Sengouga, N., Boumaraf, R., et al., “Modeling the effect of deep traps on the capacitance–voltage characteristics of p-type Si-doped GaAs Schottky diodes grown on high index GaAs substrates”. Materials Science in Semiconductor Processing, 2015. 36: p. 156-161.
- Belkaid, K., Tati, A. & Boumaraf R., “A Simple Finite Element with Five Degrees of Freedom Based on Reddy’s Third-Order Shear Deformation Theory”. Mechanics of Composite Materials, 2016. 52(2): p. 257-270.
- Participation orale a “the 1st International Conference on Materials for Energy & Environmental Engineering (ICM3E’14)” intitulé: “Modelling the effect of deep traps on the capacitance-voltage characteristics of p-type Si-doped GaAs Schottky diodes grown on”

## Langues

**Arabe:** langue maternelle; **Anglais:** Bon niveau; **Français:** Bon niveau.

## Autres Compétences

Programmation: SILVACO TCAD, C++, MATLAB.  
Connaissances informatiques: M.S. Word, Excel et PowerPoint, Origin, Endnote.